

3812
M. 87

МИНИСТЕРСТВО ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ОБЗОРЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ

Серия 2 «Полупроводниковые приборы»

ВЫПУСК 10(996)

В.В.Бачурин, В.П.Дьяконов, В.С.Ежов,
А.М.Ремнев

**МОЩНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ МДП-ТРАНЗИСТОРЫ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ**

Часть 1. Проблемы конструирования

(по данным отечественной и зарубежной печати за 1975-1982 гг.)

О Г Л А В Л Е Н И Е

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
Глава I. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМ ПРИБОРАМ	10
Глава II. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЩНЫХ ПЕРЕКЛЮЧА- ЮЩИХ МДП-ТРАНЗИСТОРОВ	14
Глава III. НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МОЩНОГО ПЕ- РЕКЛЮЧАЮЩЕГО МДП-ТРАНЗИСТОРА ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ	21
Глава IV. АППРОКСИМАЦИЯ СЕМЕЙСТВА ВАХ МОЩНЫХ МДП-ТРАНЗИСТОРОВ	26
Глава V. ПУТИ СНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ $R_{си}$ отк	30

МОСКВА

ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА»

1983

БИБЛИОТЕКА
Института электротехники
и электроники
Физический институт
ИИЭ АН СССР
ИИЭ № 1/м

8

1. МДП-транзисторы с горизонтальным каналом	30
2. ДМОП-транзисторы	32
3. МДП-транзисторы с V-образной структурой	38
Глава У1. КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТРАНЗИСТОРНОЙ ЯЧЕЙКИ	42
Глава УП. ВЫБОР ИСХОДНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПОДЛОЖКИ	46
Глава УШ. СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ МОШНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ МДП-ТРАНЗИСТОРОВ	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	59
ЛИТЕРАТУРА	60